

Угловые $S-N-D$ контакты в магнитном полеЮ. С. Бараш, А. М. Бобков¹⁾

Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, 117924 Москва, Россия

Поступила в редакцию 7 марта 2001 г.

После переработки 14 марта 2001 г.

Найдена зависимость критического тока угловых $S-N-D$ контактов с высокой прозрачностью от приложенного магнитного поля для различных ориентаций сверхпроводника с d -спариванием по отношению к плоскости раздела. Показано, что при низких температурах такая зависимость имеет в определенной области магнитных полей характерные участки с плато, отсутствующие в угловых $S-N-S$ контактах и свидетельствующие о наличии сверхпроводника со знакопеременным параметром порядка.

PACS: 74.50.+r, 74.80.Fr

Экспериментальное изучение угловых туннельных $S-I-D$ (изотропный сверхпроводник – изоляционная прослойка – сверхпроводник с d -спариванием) контактов в магнитном поле привело к одному из наиболее убедительных свидетельств о знакопеременном параметре порядка в высокотемпературных сверхпроводниках, по крайней мере приближенно отвечающем d -спариванию [1–4]. Этот метод оказывается менее чувствителен к эффектам захвата магнитного потока и асимметрии образца, чем эксперименты, использующие угловые SQUID [1, 5]. В отсутствие магнитного поля критический джозефсоновский ток I_c в угловом туннельном $S-I-D$ контакте имеет минимум (в идеальном случае обращается в нуль), в то время как в $S-I-S$ туннельном контакте величина I_c в нулевом поле имеет максимум. Данное обстоятельство использовалось как ключевое для идентификации сверхпроводников с d -спариванием на основе указанного метода [1–4]. Оно связано с компенсацией двух вкладов в джозефсоновский ток, вносимых в отсутствие поля каждой стороной угла в туннельном $S-I-D$ контакте отдельно и имеющих противоположные знаки. Для углового $S-I-S$ контакта эти токи в отсутствие поля синфазны, и при их сложении полный ток через симметричный контакт удваивается. Упомянутая компенсация имеет место, однако, лишь в туннельном пределе, а для контактов с достаточно большой прозрачностью отсутствует. Дело в том, что зависимость джозефсоновского тока от разности фаз φ в контактах с высокой прозрачностью существенно несинусоидальна (содержит высшие гармоники) и в результате $j_s(\varphi + \pi) \neq -j_s(\varphi)$. В этой связи представляет интерес изучение угловых контактов с

высокой прозрачностью и выяснение их характерного поведения при наличии сверхпроводника с d -спариванием.

В предлагаемой работе рассмотрены полностью прозрачные угловые $S-N-D$ (изотропный сверхпроводник – прослойка нормального металла – сверхпроводник с d -спариванием) контакты с шириной слоя чистого нормального металла $d \gg \xi_0$ (см. рис.1). Найден критический ток для таких систем при на-

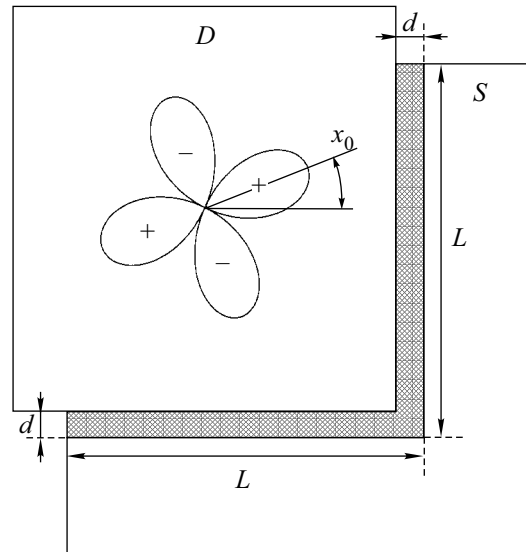


Рис.1. Схема рассматриваемого углового контакта. Магнитное поле направлено перпендикулярно плоскости рисунка, α – угол между кристаллической осью x_0 сверхпроводника с $d_{x^2-y^2}$ спариванием (D) и нормалью к границе раздела

личии внешнего магнитного поля. Показано, что в угловых контактах с высокой прозрачностью характерной особенностью интерференционных зави-

¹⁾e-mail: bobkov@lpi.ru

симостей критического тока от поля при достаточно низких температурах является наличие плато в определенном интервале значений магнитного поля. Плато наиболее выражено в характеристиках уголковых $S-N-D$ контактов с ориентациями (100) и (010) границы в сверхпроводнике с d -спариванием. С ростом температуры область с плато искажается и исчезает. Для ориентации (110) границы плато отсутствует вообще, в частности, при $T = 0$. При этом минимумы (в идеальном случае нули) у интерференционной зависимости критического тока от поля появляются, как и должно быть, с вдвое меньшим периодом, по сравнению со случаем $S-N-S$ контакта.

Пусть два чистых сверхпроводника с синглетными параметрами порядка $\Delta^l(\mathbf{p}_f, l)$, $\Delta^r(\mathbf{p}_f, r)$ занимают области $x < -d/2$ и $x > d/2$, соответственно, а в области $-d/2 < x < d/2$ находится нормальный металл. Для решения уравнений Эйленберга для запаздывающих квазиклассических гриновских функций

$$\begin{aligned} (2\omega + iv_{f,x}\partial_x)f(\mathbf{p}_f, x, \omega) + \\ + 2\Delta(\mathbf{p}_f, x)g(\mathbf{p}_f, x, \omega) = 0, \\ (2\omega - iv_{f,x}\partial_x)f^+(\mathbf{p}_f, x, \omega) - \\ - 2\Delta^*(\mathbf{p}_f, x)g(\mathbf{p}_f, x, \omega) = 0, \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} iv_{f,x}\partial_x g(\mathbf{p}_f, x, \omega) - \Delta(\hat{\mathbf{p}}, x)f^+(\mathbf{p}_f, x, \omega) - \\ - \Delta^*(\mathbf{p}_f, x)f(\mathbf{p}_f, x, \omega) = 0 \end{aligned}$$

с учетом условия нормировки

$$g^2 + ff^+ = -\pi^2 \quad (2)$$

используем следующий анзац, автоматически удовлетворяющий нормировочному условию (2):

$$\begin{aligned} f(\mathbf{p}_f, x, \omega) = (-i\pi \operatorname{sgn}(xv_{f,x}) - \\ - g(\mathbf{p}_f, x, \omega))e^{i\eta(\mathbf{p}_f, x, \omega)}, \\ f^+(\mathbf{p}_f, x, \omega) = (-i\pi \operatorname{sgn}(xv_{f,x}) + \\ + g(\mathbf{p}_f, x, \omega))e^{-i\eta(\mathbf{p}_f, x, \omega)}. \end{aligned} \quad (3)$$

Подстановка соотношений (3) в (1) приводит к уравнению для величины $\eta(\mathbf{p}_f, x, \omega)$:

$$\begin{aligned} -\frac{v_{f,x}}{2}\partial_x\eta(\mathbf{p}_f, x, \omega) + \omega - \\ - |\Delta(\mathbf{p}_f, x)| \cos(\eta(\mathbf{p}_f, x, \omega) - \phi(\mathbf{p}_f, x)) = 0 \end{aligned} \quad (4)$$

и асимптотическим условиям

$$v_{f,x} \sin(\eta_\infty(\mathbf{p}_f, \omega) - \phi_\infty(\mathbf{p}_f)) \operatorname{sgn}x > 0, \quad (5)$$

обеспечивающим ограниченность гриновской функции $g(\mathbf{p}_f, x, \omega)$ при $x \rightarrow \pm\infty$. Мы не приводим здесь явное, но громоздкое выражение для гриновской функции $g(\mathbf{p}_f, x, \omega)$ через $\eta(\mathbf{p}_f, x', \omega)$, которое легко получается при использовании указанной подстановки. В (4) и ниже введены модуль и фаза параметра порядка $\Delta(\mathbf{p}_f, x) = |\Delta(\mathbf{p}_f, x)|e^{i\phi(\mathbf{p}_f, x)}$.

Предполагая для простоты поверхности Ферми сверхпроводников и разделяющего их металла одинаковыми, имеем обычные граничные условия для гриновских функций на полностью прозрачных границах $g_l(-d/2, \mathbf{p}_f) = g_N(\mathbf{p}_f) = g_r(d/2, \mathbf{p}_f)$, $f_l(-d/2, \mathbf{p}_f) = f_N(-d/2, \mathbf{p}_f)$, $f_N(d/2, \mathbf{p}_f) = f_r(d/2, \mathbf{p}_f)$. С учетом этих соотношений нетрудно получить из (3)–(5) следующее выражение для температурной гриновской функции $g_N^M(\mathbf{p}_f, \omega_n)$ в области, занятой нормальным металлом:

$$\begin{aligned} g_N^M(\mathbf{p}_f, \omega_n) = -i\pi \operatorname{sgn}(v_{f,x}) \times \\ \times \operatorname{cth} \left[i \frac{\eta(\mathbf{p}_f, d/2, \omega_n) - \eta(\mathbf{p}_f, -d/2, \omega_n)}{2} + \frac{\omega_n d}{v_{f,x}} \right]. \end{aligned} \quad (6)$$

Эта формула верна при всех температурах и для зависящего от координат самосогласованного профиля параметра порядка $\Delta(\mathbf{p}_f, x)$. Пренебрегая подавлением параметра порядка, в области низких температур $T \ll \Delta_{max}$ получаем из (4), (5) $\eta(\mathbf{p}_f, d/2, \omega_n) - \eta(\mathbf{p}_f, -d/2, \omega_n) = \phi(\mathbf{p}_f) + \pi \operatorname{sgn}(v_{f,x})$, где $\phi(\mathbf{p}_f) = \phi_r(\mathbf{p}_f) - \phi_l(\mathbf{p}_f)$ есть разность фаз параметров порядка для заданного направления импульса. В этом приближении вычисление джозефсоновского тока j_x с использованием полученной гриновской функции приводит при условии $T \ll v_f/d \ll \Delta_{max}$ к следующему выражению [6, 7]:

$$j_x = \frac{e}{d} \int \frac{d^2 S}{(2\pi)^3 v_f} v_{f,x}^2 \operatorname{saw}(\phi(\mathbf{p}_f)). \quad (7)$$

Здесь введена имеющая “пилообразный” график функция $\operatorname{saw}(\phi)$: $\operatorname{saw}(\phi) = \phi$ на отрезке $\phi \in [-\pi, \pi]$ и $\operatorname{saw}(\phi + 2\pi) = \operatorname{saw}(\phi)$. Условие $v_f/d \ll \Delta_{max}$ удобно представить в виде $\xi_0 \ll d$, где $\xi_0 = v_f/\Delta_{max}$.

Выделяя постоянные, не зависящие от направления импульса, фазы $\varphi_{l,r}$, описываем сверхпроводники вещественными знакопеременными параметрами порядка. Это возможно, в частности, для сверхпроводников с d -спариванием. Пусть S_f^+ (S_f^-) есть та часть поверхности Ферми S_f , на которой параметры порядка $\Delta_{l,r}(\mathbf{p}_f, 0)$ имеют одинаковые (противоположные) знаки. Тогда, обозначая постоянную разность фаз через $\varphi = \varphi_r - \varphi_l$, имеем $\phi(\mathbf{p}_f) = \varphi$ для

$\mathbf{p}_f \in S_f^+$ и $\phi(\mathbf{p}_f) = \varphi + \pi$ для $\mathbf{p}_f \in S_f^-$. Далее определим величины a^\pm соотношениями

$$a^\pm = \frac{A\{S_f^\pm\}}{A\{S_f\}}, \quad \text{где } A\{S_f^+\} = \int_{S_f^+} \frac{d^2 S_f v_{f,x}^2}{(2\pi)^3 v_f}, \quad (8)$$

и аналогично определены $A\{S_f^-\}$, $A\{S_f\}$. Очевидно, $S_f^+ + S_f^- = S_f$, откуда следует $a^+ + a^- = 1$. Величины a^\pm существенно зависят от типа спаривания и взаимной ориентации сверхпроводящих кристаллов, а также и от формы поверхности Ферми. В то же время они нечувствительны к конкретному виду базисных функций соответствующего представления точечной группы сверхпроводящего кристалла. Для сверхпроводников со знакопостоянными параметрами порядка на всей поверхности Ферми (анизотропное s -спаривание) a^\pm принимают значения $a^+ = 1$, $a^- = 0$ (либо $a^- = 1$, $a^+ = 0$, если постоянные знаки двух параметров порядка противоположны).

Задача о токе через уголкового контакта, вообще говоря, имеет двумерный характер. Будем считать, что характерная протяженность контакта L удовлетворяет соотношениям $\lambda_{l,r} \ll L \ll \lambda_j$, где $\lambda_{l,r}$ и λ_j есть глубины проникновения магнитного поля в массивные сверхпроводники и в джозефсоновский контакт, соответственно. Тогда при условии $H \ll H_{c1} \sim \Phi_0/\lambda_{l,r}^2$ поток магнитного поля через содержащую угол область с характерной площадью порядка $\lambda_{l,r}^2$ много меньше кванта потока, и задача приближенно сводится к одномерной. При этом собственным магнитным полем в контакте можно пренебречь.

В данных условиях рассматриваем плоский контакт в магнитном поле, направленном параллельно

границе раздела вдоль оси z . В направлении y контакт предполагается состоящим из двух частей, соответствующих в данной одномерной задаче двум сторонам угла. По сравнению с областью $0 < y < L$, в области $-L < y < 0$ для каждого из направлений импульсов к разности фаз в контакте добавляется π . Этим учитывается изменение знака параметра порядка в сверхпроводнике с d -спариванием при повороте импульса квазичастицы на $\pi/2$ вокруг оси z , совпадающей с тетрагональной осью кристалла. Ниже под уголкового контактом понимаем данную одномерную модель.

Учет влияния магнитного поля H на джозефсоновский ток сводится к подстановке в (7) $\phi(\mathbf{p}_f) \rightarrow \phi(\mathbf{p}_f) + (2eHy/c)(d + \lambda_l + \lambda_r)$, где d – толщина прослойки нормального металла и $\lambda_{l,r}$ – глубины проникновения магнитного поля в левый и правый сверхпроводники, соответственно. Поток магнитного поля $\Phi = 2HL(d + \lambda_l + \lambda_r)$ через слой нормального металла и приповерхностные слои сверхпроводников ($2L$ – протяженность границ рассматриваемого контакта вдоль оси y) удобно измерять в единицах кванта потока $n = \Phi/\Phi_0 \equiv |e|\Phi/\pi c$. Распределение тока в направлении поля (вдоль оси z) и само магнитное поле в контакте малых размеров считаем однородными. Тогда для джозефсоновского критического тока в обычном плоском $S-N-D$ контакте приходим к результату работы [8]. Вычисляя полный ток через уголкового $S-N-D$ контакт и находя его максимальные значения в зависимости от величины внешнего магнитного поля, приходим к следующим соотношениям:

$$\frac{j_{c0}(H)}{j_{c0}(0)} = \frac{2}{n} \begin{cases} \left\{ \frac{n}{2} \right\} \max \left[\left(1 - 4 \left\{ \frac{n}{2} \right\} \right), |a^+ - a^-| \right], & \left\{ \frac{n}{2} \right\} \leq \frac{1}{4}; \\ \max \left[\left\{ \frac{n}{2} \right\} |a^+ - a^-|, \left(4 \left\{ \frac{n}{2} \right\} - 1 \right) \left| a^\pm - \left\{ \frac{n}{2} \right\} \right| \right], & \frac{1}{4} \leq \left\{ \frac{n}{2} \right\} \leq \frac{1}{2}; \\ \max \left[\left(1 - \left\{ \frac{n}{2} \right\} \right) |a^+ - a^-|, \left(3 - 4 \left\{ \frac{n}{2} \right\} \right) \left| a^\pm - \left\{ \frac{n}{2} \right\} \right| \right], & \frac{1}{2} \leq \left\{ \frac{n}{2} \right\} \leq \frac{3}{4}; \\ \left(1 - \left\{ \frac{n}{2} \right\} \right) \max \left[|a^+ - a^-|, \left(4 \left\{ \frac{n}{2} \right\} - 3 \right) \right], & \frac{3}{4} \leq \left\{ \frac{n}{2} \right\} \leq 1. \end{cases} \quad (9)$$

Здесь $\{n/2\}$ есть дробная часть магнитного потока, пронизывающего уголкового контакт с одной из сторон угла.

Как видно из (9) и рис.2, в области полей $(1 - |a^+ - a^-|)/2 < n < \max(a^+, a^-)$ на кривой $j_{c0}(H)$ имеется плато: критический ток есть $j_{c0}(0)|a^+ - a^-|$

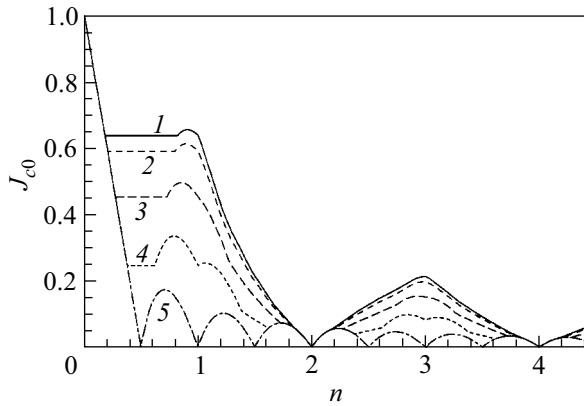


Рис.2. Зависимость $J_{c0} = j_{c0}(H)/j_{c0}(0)$ от $n = \Phi/\Phi_0$ при нулевой температуре, вытекающая из (9) для различных ориентаций сверхпроводника с $d_{x^2-y^2}$ спариванием, тетрагональная ось которого параллельна магнитному полю. Кривым 1-5 отвечают, соответственно, следующие значения угла α между кристаллической осью x_0 и нормалью к поверхности: $0, \pi/16, \pi/8, 3\pi/16, \pi/4$. Плато имеет максимальную ширину для ориентации (100)

и не зависит от магнитного поля. Поскольку такие участки у зависимости критического тока от магнитного поля в $S-N-S$ контактах не возникают вовсе [9, 6], их наличие при низких температурах свидетельствует о присутствии в контакте сверхпроводника со знакопеременным параметром порядка.

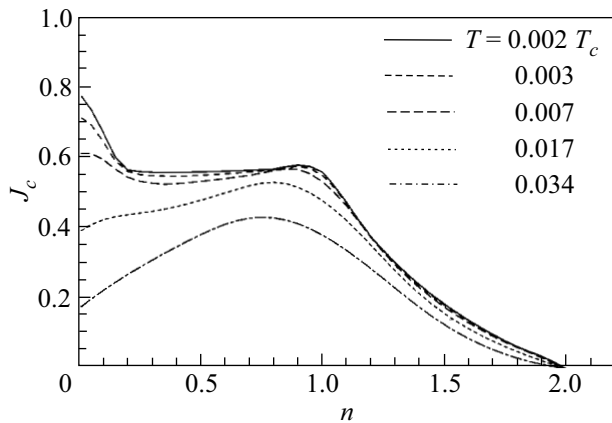


Рис.3. Зависимость $J_c = j_c(H)/j_{c0}(0)$ в угловом $S-N-D$ контакте для ориентации $\alpha = 0^\circ$ при различных температурах и $\xi_0/d = 0.1$

Если в одном из сверхпроводников реализуется $d_{x^2-y^2}$ -спаривание и его кристаллическая ось z_0 параллельна плоскости контакта, а во втором – изотропное s -спаривание, то $a^\pm = 1/2 \pm \cos 2\alpha/\pi$, где α есть угол между осью x_0 кристалла и нормалью

к границе раздела. В данном случае плато находится в интервале полей $(\pi - 2|\cos 2\alpha|)/2\pi < n < (\pi + 2|\cos 2\alpha|)/2\pi$ на уровне $2|\cos 2\alpha|/\pi$ от критического тока в нулевом поле. Для ориентации $\alpha = 0$ область с плато имеет наибольшую протяженность, а для $\alpha = 45^\circ$ плато отсутствует. В последнем случае $a^+ = a^- = 1/2$. При этом, как и в обычном плоском $S-N-D$ контакте [8], критический ток в угловом контакте обращается в нуль через полкванта потока ($n = 0.5, 1, 1.5, \dots$), то есть с вдвое меньшим периодом, чем обычно. Такое поведение обусловлено специфической симметрией задачи при $\alpha = 45^\circ$ и должно проявляться не только для металлических, но и для изоляционных прослоек [10].

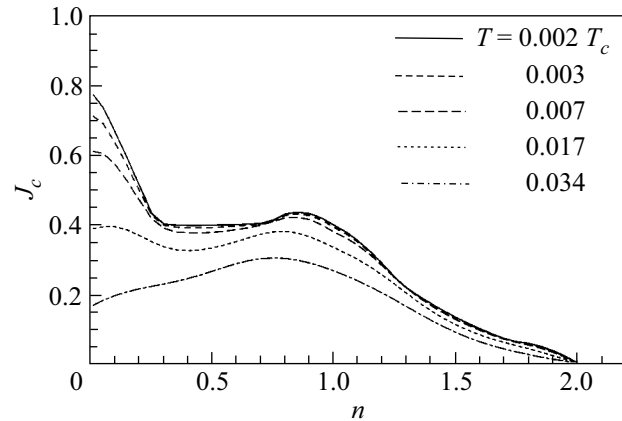


Рис.4. Зависимость $j_c(H)/j_{c0}(0)$ для ориентации $\alpha = 22.5^\circ$ при различных температурах и $\xi_0/d = 0.1$

Найденное характерное поведение критического тока для угловых $S-N-D$ контактов в магнитном поле, и прежде всего наличие плато и линейных зависимостей от поля, тесно связано с исходной пилообразной зависимостью джозефсоновского тока от разности фаз в рассматриваемых системах [11, 6, 7]. По сравнению с $S-N-S$ контактом, для $S-N-D$ контакта пилообразная зависимость джозефсоновского тока от разности фаз усложняется, и для нее уже $j_x(\varphi) \neq j_x(-\varphi)$ и есть разрыв при $\varphi = 0$. Вследствие этого в основном состоянии сверхпроводящего кольца, содержащего $S-N-D$ контакт, имеется спонтанный ток [7]. Далее, спонтанный ток возникает и вдоль поверхности $S-N-D$ контакта, будучи локализован, в основном, в прослойке [12, 13]. Он экранируется мейснеровскими токами в сверхпроводниках. При наличии спонтанного тока, вообще говоря, возможно появление небольшой асимметрии критического тока по отношению к изменению знака приложенного поля. Существенного изменения основных

результатов данной работы о зависимости критического тока от внешнего магнитного поля при этом не возникает.

Полученное поведение критического тока искажается с ростом температуры в меру искажения упомянутой пилообразной зависимости. На рис.3, 4 и 5 показаны зависимости критического тока $S-N-D$ контакта от магнитного поля при разных температу-

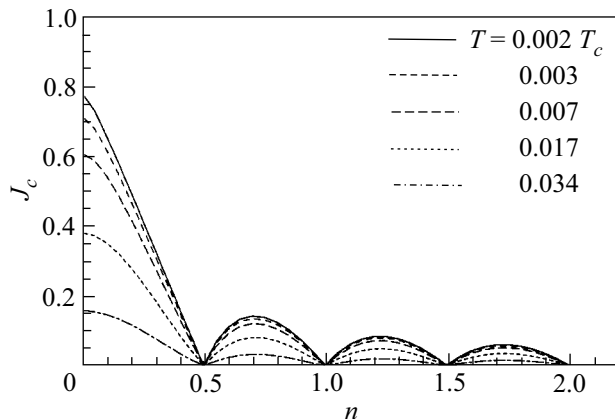


Рис.5. Зависимость $j_c(H)/j_{c0}(0)$ для ориентации $\alpha = 45^\circ$ при различных температурах и $\xi_0/d = 0.1$

рах и ориентациях сверхпроводника с d -спариванием. Ширина прослойки нормального металла принята равной $10\xi_0$. Подавлением параметра порядка вблизи прозрачной границы раздела пренебрежено. Из приведенных графиков видно, что в случае высокотемпературных сверхпроводников с $T_c \sim 100$ К наличие

плато в уголкового $S-N-D$ контактах можно ожидать при температурах порядка $(0.1 \div 0.5)$ К.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант # 99-02-17906.

1. D. A. Wollman, D. J. van Harlingen, W. C. Lee et al., Phys. Rev. Lett. **71**, 2134 (1993).
2. D. A. Wollman, D. J. van Harlingen, J. Giapintzakis, and D. M. Ginzberg, Phys. Rev. Lett. **74**, 797 (1995).
3. D. J. van Harlingen, Rev. Mod. Phys. **67**, 515 (1995).
4. J. H. Jr. Miller, Q. Y. Ying, Z. G. Zou et al., Phys. Rev. Lett. **74**, 2347 (1995).
5. B. M. Hinaus, M. S. Rzchowski, N. Heinig et al., Phys. Rev. **B54**, 6770 (1996).
6. А. В. Свидзинский, *Пространственно-неоднородные задачи теории сверхпроводимости*, М.: Наука, 1982.
7. Yu. S. Barash, A. V. Galaktionov, and A. D. Zaikin, Phys. Rev. **B52**, 665 (1995).
8. A. M. Zagoskin, J. Phys.: Condensed Matter **9**, L419 (1997).
9. Т. Н. Анцыгина, Е. Н. Братусь, А. В. Свидзинский, ФНТ **1**, 49 (1975).
10. E. Il'ichev, V. Zakosarenko, R. P. J. IJsselsteijn et al., Phys. Rev. **B60**, 3096 (1997).
11. C. Ishii, Progr. Theor. Phys. **44**, 1525 (1970).
12. A. Huck, Anne van Otterlo, and M. Sigrist, Phys. Rev. **B56**, 14163 (1997).
13. A. M. Zagoskin and M. Oshikawa, J. Phys.: Condensed Matter **10**, L105 (1998).